

Rec'd PCT/PTO 19 MAY 2005

PCT/DE 03/03/10

BUNDE●REPUBLIC DEUTSCH●LAND

10/535448



REC'D 04 FEB 2004

WIPO PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen:

102 53 953.7

Anmeldetag:

19. November 2002

Anmelder/Inhaber:

Siemens Aktiengesellschaft, München/DE

Bezeichnung:

Organisches elektronisches Bauelement mit
strukturierter halbleitender Funktionsschicht
und Herstellungsverfahren dazu

IPC:

H 01 L 51/00

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 24. November 2003
Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

Stech

BEST AVAILABLE COPY



Beschreibung

Organisches elektronisches Bauelement mit strukturierter
halbleitender Funktionsschicht und Herstellungsverfahren dazu

5

Die Erfindung betrifft ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor und ein Herstellungsverfahren dazu, wobei die halbleitende Schicht des Bauelements strukturiert ist.

10

Bei organischen elektronischen Bauelementen werden die organischen halbleitenden Funktionsschichten üblicherweise großflächig durch Spin-coating, Aufsprühen, Rakeln oder ähnliches als homogene großflächige aber sehr dünne Funktionsschichten aufgebracht.

15

Bei einer integrierten Schaltung kann das zu Problemen führen, da Leckströme von einem Bauelement oder von einer Elektrode zur nächsten entstehen, wenn die halbleitenden Funktionsschichten der Bauelemente aneinander stoßen. Diese Leckströme stören die Performance der Schaltung zum Teil erheblich. Deshalb werden Versuche unternommen, die halbleitenden Funktionsschichten zu strukturieren und/oder sie auf die aktiven Flächen, also die Bereiche wo sich Stromkanäle ausbilden, zu reduzieren. Diese Strukturierung kann bei photolithographisch hergestellten Bauelementen durch entsprechende Belichtungsmasken erreicht werden. Für eine breite Anwendung werden aber photolithographisch hergestellte Bauelemente zu teuer. Deshalb wird bei der Entwicklung der Elemente auf preisgünstige Druckherstellungsmethoden fokussiert.

30

Die halbleitende Funktionsschicht kann jedoch nicht durch herkömmliche Druckmethoden strukturiert aufgebracht werden, weil diese Schicht sehr dünn sein muss (typischerweise kleiner 100nm), damit sie funktioniert. Die beispielsweise für die halbleitende Funktionsschicht geforderten Schichtdicken

35

sind herkömmlicherweise nur über Belackung wie Coating, Aufsprühen etc. zu erreichen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, bei gedruckt her-
5 gestellten organischen elektronischen Bauelementen eine
Strukturierung einer dünnen, insbesondere der halbleitenden
Funktionsschicht zu ermöglichen, ohne dass dabei die Schicht-
dicke der betroffenen Funktionsschicht gegenüber einer norma-
lerweise durch Belackung (Coating, Aufsprühen, Einrakeln)
10 hergestellten, z.B. halbleitenden, Funktionsschicht gesteigert wird.

Gegenstand der Erfindung ist ein organisches elektronisches
Bauelement mit einer strukturierten halbleitenden Funktions-
15 schicht einer Dicke kleiner 100nm, wobei die Strukturierung
dadurch entsteht, dass eine untere Funktionsschicht nur partiell
mit dem organischen Funktionsmaterial der nächsten
Funktionsschicht benetzt wird. Außerdem ist Gegenstand der
Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines organischen
20 elektronischen Bauelements, bei dem durch gezielte Behandlung
einer unteren Funktionsschicht eine obere Funktionsschicht
trotz großflächiger Auftragung strukturiert erzeugt wird.

Nach einer Ausführungsform des Verfahrens wird eine halbleitende
25 Schicht strukturiert erzeugt.

Nach einem Ausführungsbeispiel wird die untere Funktionsschicht
durch einen Lack partiell abgedeckt, der durch Drucken in ganz geringer
Schichtdicke aufbringbar ist.

30 Als obere, strukturierte Funktionsschichten können durch das
Verfahren halbleitende, isolierende, und/oder leitende organische
Funktionsschichten, aber natürlich auch anorganische Funktionsschichten,
wie z.B. dünne Metallschichten strukturiert hergestellt werden.
35

Die untere Funktionsschicht ist je nach Aufbau des organischen elektronischen Bauelements und der oberen Schicht das Substrat, eine leitende Funktionsschicht etc.

5 Als „gezielte Behandlung“ wird die partielle Abdeckung und/oder die lokale Veränderung der unteren Funktionsschicht bezeichnet, die bewirkt, dass in ausgewählten Bereichen der unteren Funktionsschicht beim Belacken mit dem Material Benetzung stattfindet oder vermieden wird (also „partielle Benetzung“ stattfindet), kann mittels einer Druckmethode, durch
10 Laserbehandlung, Wärmebehandlung, andere physikalische, elektrische oder chemische Behandlung, immer jedoch partiell und mit einer Auflösung im μm -Bereich, erfolgen. Beispielhaft genannt sei die partielle Kontaktierung mit Säure/Base oder
15 anderen reaktiven chemischen Substanzen, physikalische Effekte wie Licht, Wärme, Kälte und schließlich die mechanische Behandlung wie Reiben. Die Folge der Behandlung ist in jedem Falle die, dass die nächste Funktionsschicht auf den behandelten Stellen nicht oder nur dort benetzt.

20

Der Begriff „organisches Material“ und/oder „Funktionspolymer“ umfasst hier alle Arten von organischen, metallorganischen und/oder anorganischen Kunststoffen, die im Englischen z.B. mit „plastics“ bezeichnet werden. Es handelt sich um alle Arten von Stoffen mit Ausnahme der Halbleiter, die die klassischen Dioden bilden (Germanium, Silizium), und der typischen metallischen Leiter. Eine Beschränkung im dogmatischen Sinn auf organisches Material als Kohlenstoff enthaltendes Material ist demnach nicht vorgesehen, vielmehr ist
30 auch an den breiten Einsatz von z.B. Siliconen gedacht. Weiterhin soll der Term keiner Beschränkung im Hinblick auf die Molekülgröße, insbesondere auf polymere und/oder oligomere Materialien unterliegen, sondern es ist durchaus auch der Einsatz von „small molecules“ möglich.

35

Im folgenden wird die Erfindung noch anhand zweier Figuren, die eine Draufsicht und einen Querschnitt durch ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen organischen elektronischen Bauteils zeigen:

5

Figur 1 zeigt eine Aufsicht auf eine Schaltung mit einer strukturierten halbleitenden Funktionsschicht. Zu sehen ist eine organische Schaltung, die auf einem Substrat (verdeckt) aufgebaut ist. Es sind mehrere aktive Elemente wie organische
10 Feld-Effekt-Transistoren nebeneinander angeordnet, zu erkennen sind jeweils die Source/Drain Elektroden 2. Der schraffierte Bereich zeigt die organische Halbleiterschicht 1, die strukturiert ist und Teilbereiche 3 hat, die frei von halbleitendem Funktionsmaterial sind. Durch den freien Bereich 3
15 („frei“ heißt hier weder mit leitendem noch mit halbleitendem Material bedeckt) wird ein Leckstrom vom linken in den rechten Bereich der Schaltung unterdrückt.

Figur 2 zeigt einen OFET mit dem Substrat 4 und den Source/Drain Elektroden 2. Auf der leitenden Funktionsschicht, den Source/Drain Elektroden 2 befindet sich die strukturierte halbleitende Funktionsschicht 1, die sich nicht ganzflächig über die leitende Funktionsschicht 2 erstreckt, sondern die durch den Lack 6, der das Substrat 4 partiell gegen die Be-
20 netzung mit halbleitender Funktionsschicht 1 abdeckt, unterbrochen, also strukturiert nur die aktiven Flächen, das heißt die Flächen oberhalb der Source/Drain Elektroden, bedeckt. Die halbleitende Funktionsschicht ihrerseits wird durch die isolierende Funktionsschicht 5 bedeckt, auf der sich die Ga-
25 te-Elektroden 7 befinden.

Die Erfindung betrifft ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor und ein Herstellungsverfahren dazu, wobei eine dünne Schicht, wie die
35 halbleitende Schicht des Bauelements strukturiert ist, obwohl das Bauelement im preisgünstigen Druckverfahren herstellbar ist. Um dies zu erreichen wird die untere Funktionsschicht

durch eine Behandlung so präpariert, dass sie Teilbereiche hat, auf denen im nachfolgenden Prozessschritt Benetzung stattfindet und Teilbereiche, auf denen keine Benetzung erfolgt.

Patentansprüche

1. Organisches elektronisches Bauelement mit einer strukturierten Funktionsschicht einer Dicke kleiner 100nm, wobei die
5 Strukturierung dadurch entsteht, dass eine untere Funktionsschicht nur partiell mit dem organischen Funktionsmaterial der nächsten Funktionsschicht benetzt wird.
2. Organisches elektronisches Bauelement nach Anspruch 1, bei
10 dem die strukturierte Funktionsschicht eine halbleitende Funktionsschicht ist.
3. Verfahren zur Herstellung eines organischen elektronischen Bauelements, bei dem durch gezielte Behandlung einer unteren
15 Funktionsschicht eine obere Funktionsschicht trotz großflächiger Auftragung strukturiert erzeugt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem eine halbleitende Funktionsschicht strukturiert erzeugt wird.
20
5. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem die untere Funktionsschicht durch einen Lack partiell abgedeckt wird, der durch Drucken in ganz geringer Schichtdicke aufbringbar ist.

Zusammenfassung

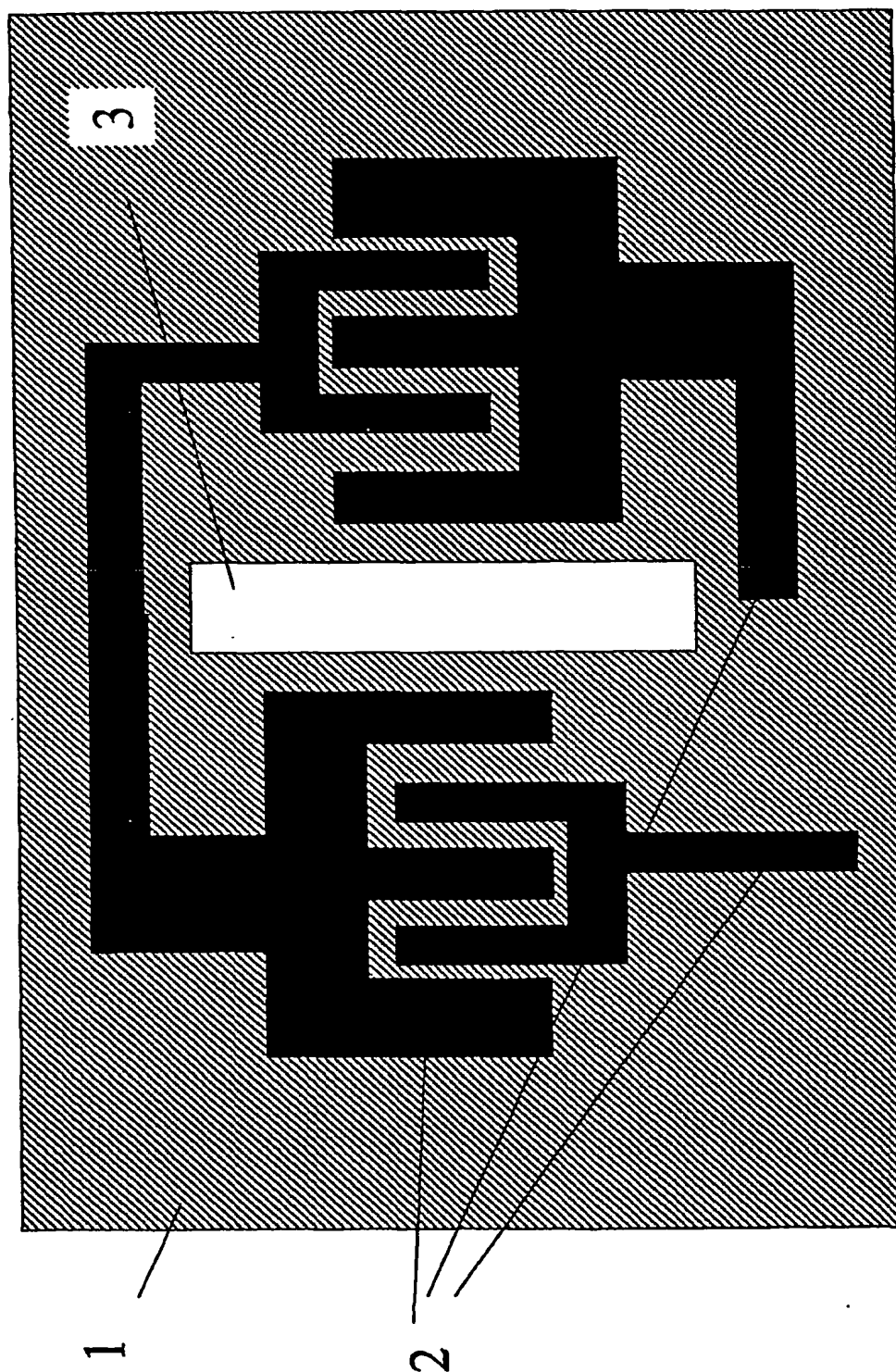
Organisches elektronisches Bauelement mit strukturierter
halbleitender Funktionsschicht und Herstellungsverfahren dazu

5

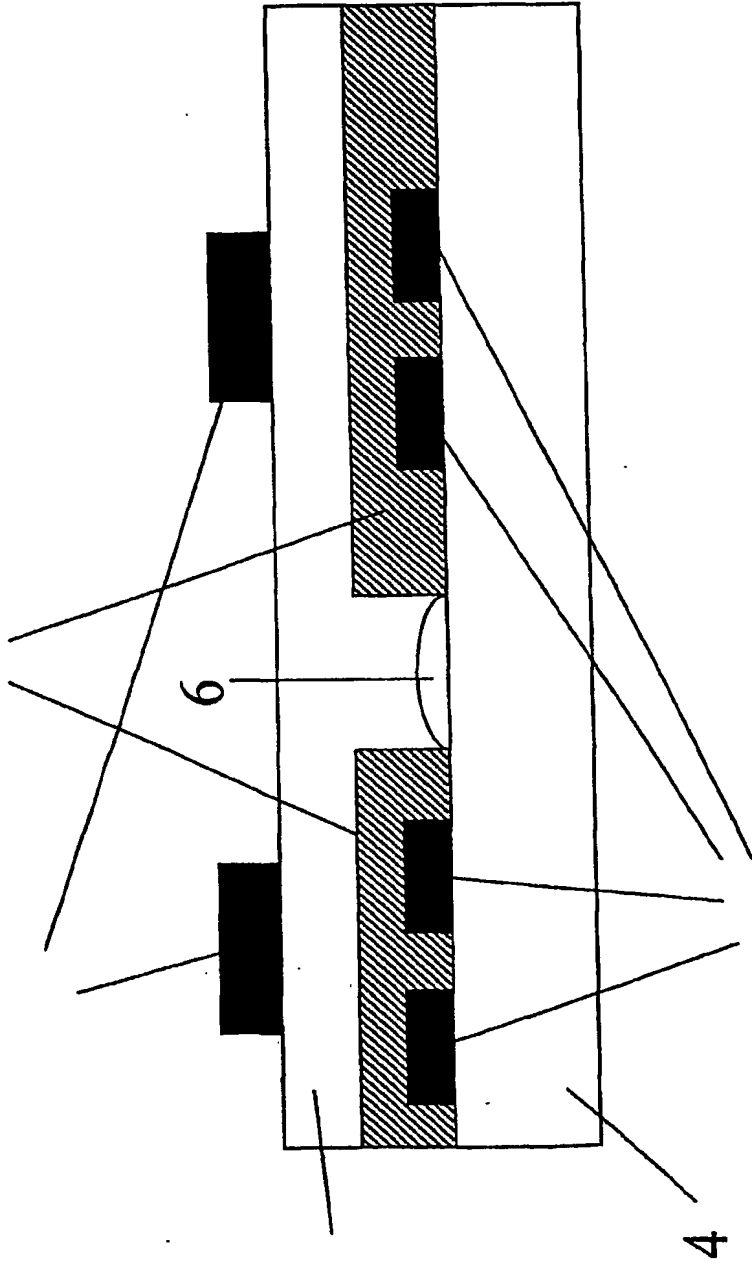
Die Erfindung betrifft ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor und ein Herstellungsverfahren dazu, wobei die halbleitende Schicht des Bauelements strukturiert ist, obwohl das Bauelement im preisgünstigen Druckverfahren herstellbar ist. Um dies zu erreichen wird die untere Funktionsschicht durch eine Behandlung so präpariert, dass sie Teilbereiche hat, auf denen im nachfolgenden Prozessschritt Benetzung stattfindet und Teilbereiche, auf denen keine Benetzung erfolgt.

15

Figure 1/2



Figur 2/2



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.